

パッケージからパワーデバイス、装置電源まで 一次世代半導体を支える急冷凝固技術

ガスアトマイズ金属粉末

液体急冷金属薄帯

— 製品特徴 —

- ① 高球状性・高純度
- ② 焼結性に優れた微細粒径
- ③ 合金設計の柔軟性

— 半導体関連用途 —

スパッタリングターゲット材：
薄膜形成用（Al, Cu, Ti 等）

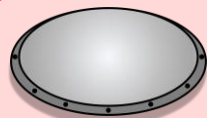
高密度放熱部品材：
パワーデバイスの温度管理に貢献
（W-Cu合金等）

リードフレーム：
導電性接着剤によるICチップとの
接着、機能性向上の表面処理
（メッキ、スパッタリング）

チップインダクタコア：
パワー半導体向け



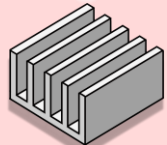
素材：金属粉末



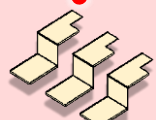
スパッタリング
ターゲット
▶ 薄膜の成膜用



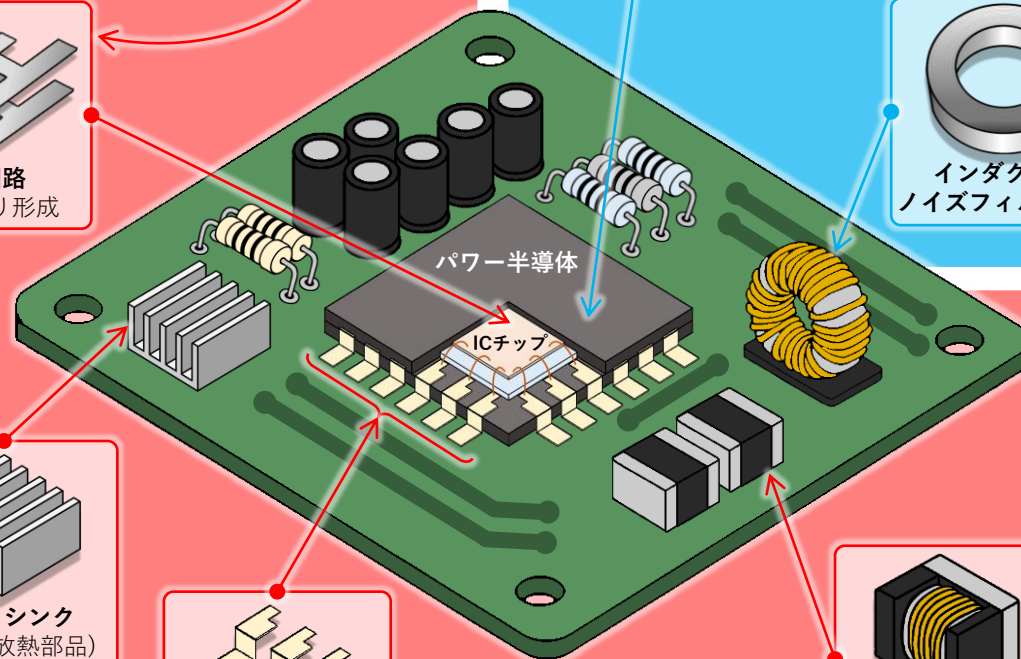
集積回路
▶ 薄膜より形成



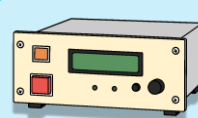
ヒートシンク
（高密度放熱部品）



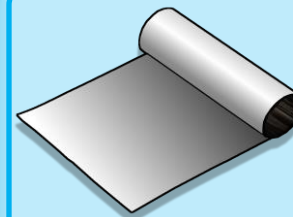
リードフレーム
▶ ICチップとの接着
▶ 機能性向上の表面処理



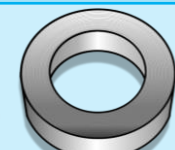
基板略図



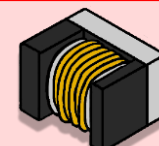
高周波電源の
トランス
▶ 半導体製造装置用



材料：金属薄帯



インダクタ/
ノイズフィルタコア



チップインダクタ
コア

— 製品特徴 —

- ① 高周波領域での低損失特性
- ② 高飽和磁束密度、優れた透磁率
- ③ 優れた温度安定性とノイズ抑制性能

— 半導体関連用途 —

製造装置用高周波電源のトランス：
RFエネルギー制御に使用

インダクタ・トランスコア：
パワー半導体向け（SiC/GaN対応）

ノイズフィルタコア：
EMC対策により、機器の電磁環境
適合に貢献